样品校准法在单波长椭偏仪中的应用

徐鹏^{1,2} 刘 涛² 王林梓² 李国光^{2*} 熊 伟² 荣 健¹

(2)中国科学院微电子研究所中国科学院微电子器件与集成技术重点实验室,北京 100029/

摘要 椭偏仪是薄膜测量的重要工具。从模拟和实验两方面,描述一种新颖的单波长椭偏仪的校准方法。该方法 的基本思路是:如果被测样品的相关信息(折射率 n,吸收系数 k,厚度 d)已知,则可以通过测量光强变化的傅里叶 系数,采用最小二乘法原理反演出此时椭偏系统的信息(即校准参数,包括起偏器方位角 P,检偏器方位角 A,波片 起始旋转角 C_s,波片位相延迟 δ,系统入射角 θ₀)。利用校准得到的系统参数和测量未知样品得到的光强傅里叶系 数,求得未知样品的厚度。该方法具有操作简单、节约成本等优点。分别针对 2~6 个样品尝试了校准,对该校准 方法做了模拟分析。将该方法用于实际测量,考证校准后的测量效果,并做了误差分析,最大误差为 0.26 nm。 关键词 薄膜;椭偏校准方法;最小二乘法;校准参数;模拟和实验分析

中图分类号 O436.3 文献标识码 A **doi:** 10.3788/AOS201333.0412002

Calibration Method for Single Wavelength Ellipsometry Using Standard Samples

Xu Peng^{1,2} Liu Tao² Wang Linzi² Li Guoguang² Xiong Wei² Rong Jian¹

¹ School of Physical Electronics, University of Electronic Science and Technology of China,

Chengdu, Sichuan 610054, China

² Key Laboratory of Microelectronics Devices and Integrated Technology, Institute of Microelectronics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China

Abstract Ellipsometry is an important measurement tool for thin films. A novel calibration method is described for single wavelength ellipsometry, both theoretically (with simulation) and experimentally. The basic idea is as follows: if the relevant information (refractive index n, absorption coefficient k, thickness d) of samples is given prior to measurements, the system calibrating parameters (angle of polarizer P, angle of analyzer A, offset angle of compensator C_s , phase shift of compensator δ , and angel of incidence θ_0) can be deduced from the comparison of the measured and calculated Fourier coefficients, with the least square method. These calibrated system parameters can then be used to measure unknown samples. This method is easy to implement and cost-saving. $2 \sim 6$ samples have been tested in the calibrations, and the errors are analyzed with simulation. Finally, this method is applied to a realistic 632.8 nm laser ellipsometer, and the results obtained with the new calibration method prove the validity of the method and show a maximum error of 0.26 nm.

Key words thin films; ellipsometry calibration method; least square method; calibration parameter; analysis in simulation and experiment

OCIS codes 120.2130; 120.4640; 120.5700

1

引 言 最近,椭偏仪广泛应用于表征四面体非晶碳薄 膜的化学键结构^[1]以及多层复合膜的研究^[2]。与此同时,薄膜粗糙度对椭偏测量影响的研究^[3]以及如

基金项目: 国家重大专项(2011ZX02101-005)资助课题。

作者简介: 徐 鹏(1987—),男,硕士研究生,主要从事椭偏仪方面的研究。E-mail: xupengbeijing2012@163.com **导师简介**: 荣 健(1962—),男,博士,教授,主要从事空间光电系统方面的研究。E-mail: rongj@uestc.edu.cn * 通信联系人。E-mail: liguoguang@ime.ac.cn

¹ 电子科技大学物理电子学院,四川 成都 610054

收稿日期: 2012-11-01; 收到修改稿日期: 2012-12-05

何最小化椭偏测量误差的方法也有报道^[4]。椭偏仪 通常由光源、偏振器、样品和光谱仪组成,例如旋转 检偏器的椭偏仪^[5]和旋转起偏器的椭偏仪系统^[6]。 然而,考虑到测量的灵敏度和准确性,将补偿器加入 到椭偏仪系统中,构成起偏器-样品-补偿器-检偏器 (PSCA)或起偏器-补偿器-样品-检偏器(PCSA)椭 偏系统以及双补偿器的起偏器-波片-样品-波片-检 偏器(PCSCA)系统^[7]。在单一波长的椭偏仪中,所 用补偿器通常是 1/4 波片^[8]。在确定相对于入射平 面的光学元件的方位角的校准过程中,有许多不同 的校准方法^[9]被开发出来。

椭偏系统,按所旋转的偏振元件的不同,大致分为三类:旋转起偏器的椭偏仪(RPE)、旋转检偏器的 椭偏仪(RAE)和旋转补偿器的椭偏仪(RCE)。更 进一步地,通常按照偏振元件的排列顺序以及旋转 与否,将椭偏仪系统又大致分为 P_RSA、PSA_R、 PSCA_R、PSC_RA、PC_RSA 以及 PC_RSC_RA 等。从测 量敏感度上来看,PSC_RA 与 PC_RSA 差异并不大。 而 PSC_RA 与其他结构相比,具有明显的优势:

1) RAE, RPE 在样品的 Δ 近似为 0°或者 ±180°时,检偏器探测到的反射光是近似的线偏振 光,测量灵敏度不够。RCE 能够有效克服此问题^[10] (其中 Δ 为样品反射引起的 p 偏振光和 s 偏振光的 相对相位差)。

2) RAE, RPE 椭圆偏振光的左旋和右旋性质 分不开,即 Δ 的符号不能充分确定。而 RCE 能完 整测到 Δ 的正弦和余弦值,确定 Δ 的符号^[11]。

3) RPE,RAE 会分别受到光源偏振性(由于 P 在转动)和探测系统(由于 A 在转动)灵敏性的影响,造成系统误差。而 RCE 可有效避免这两类误 差^[10]。

鉴于此,本文使用的单波长的椭偏仪结构为 PSC_RA。传统的椭偏仪的校准方案是通过步进旋转起偏器,首先确定起偏器 P的方位角,进而通过 傅里叶系数的函数性质,得到校准值 C_s和 A 的 值^[10]。但步进旋转总是会受到机械精度的限制。 最重要的是,传统方法要求起偏器可旋转,并且精度 要求高,无疑会导致系统的成本增加。在本校准方 案中,只需要旋转补偿器,避免旋转其他的光学元 件。这种校准方法具有速度更快、操作更简单、节省 空间和成本等优点。新颖的校准方法的基本思想 是:如果被测样品的信息(折射率 n、吸收系数 k、厚 度d)已知,则可以通过测量光强变化的傅里叶系 数,采用最小二乘法原理反演出此时椭偏仪系统的 信息(即校准参数起偏器方位角 P、检偏器方位角 A、波片旋转起始角 C_s、波片位相延迟 δ、系统入射 角θ₀)。本文对新颖校准方法进行了数学模拟和敏 感度分析,还将其应用到测量中,并与 Horiba 椭偏 仪(型号 UVISEL2,光谱范围 190~2100 nm)测得 的厚度做比较。

2 单波长 PSC_RA 系统简介

2.1 PSC_RA 系统结构图

图 1 为单波长 PSC_RA 系统结构图。系统主要 组成部分有:光源,采用 He-Ne 激光器,输出波长 632.8 nm;起偏器和检偏器,分别用于产生和检测 偏振光;待测样品,可为薄膜或者半导体晶片;波片, 又称相位延迟器,用于改变偏振光的相位差,测量时 处于旋转状态;光探测器,用于探测光的强度;数据 采集和处理单元,用于分析实验数据,输出测量 结果。



图 1 单波长 PSC_RA 系统结构图 Fig. 1 Schematic drawing of single-wavelength PSC_RA ellipsometry

2.2 PSC_RA 系统数学模型

通常椭偏仪系统的数学模型用琼斯矩阵和穆勒 矩阵来描述,每一个偏振元件对应一个矩阵,光每经 过一个元件,就乘以其对应的矩阵。最终的光强从 所有系统矩阵乘积的结果中加以提取。琼斯矩阵表 达简单,但由于矩阵元为复数,在表达式的推导过程 中不太方便。相对而言,虽然穆勒矩阵表达复杂,但 各项均为实数,便于推导,且最终光强刚好与斯托克 斯矢量相对应,物理意义明确。PSC_RA 系统矩阵 如下:

$$\boldsymbol{s}_{\mathrm{D}} = \boldsymbol{M}_{\mathrm{A}}\boldsymbol{R}(A-C)\boldsymbol{M}_{\boldsymbol{\partial}}\boldsymbol{R}(C)\boldsymbol{M}_{\boldsymbol{\Psi}\boldsymbol{\Delta}}\boldsymbol{R}(-P)\boldsymbol{M}_{\mathrm{P}}\boldsymbol{s}_{\mathrm{0}},$$
(1)

式中

经过推导得到,其光强具有如下形式[10]:

为了方便,在采用穆勒矩阵推导时, M_{A} 、 M_{P} 两矩阵的系数 $\frac{1}{2}$ 忽略掉,推导得到^[12]:

 $\begin{aligned} \alpha_0 &= 1 - \cos 2P \cos 2\Psi + \frac{1}{2} (1 + \cos \delta) \left[\cos 2A (\cos 2P - \cos 2\Psi) + \sin 2A \sin 2P \sin 2\Psi \cos \Delta \right], \quad (4) \\ \alpha_2 &= -\sin \delta \sin 2A \sin 2P \sin 2\Psi \sin \Delta, \quad (5) \\ \beta_2 &= \sin \delta \cos 2A \sin 2P \sin 2\Psi \sin \Delta, \quad (6) \\ \alpha_4 &= 1/2 (1 - \cos \delta) \left[\cos 2A) \cos 2P - \cos 2\Psi \right] - \sin 2A \sin 2P \sin 2\Psi \cos \Delta \right], \quad (7) \\ \beta_4 &= 1/2 (1 - \cos \delta) \left[\cos 2A \sin 2P \sin 2\Psi \cos \Delta + \sin 2A (\cos 2P - \cos 2\Psi) \right]. \quad (8) \end{aligned}$

的夹角,A 为检偏器透振方向与入射平面的夹角; C_s 为波片的初始旋转角,(Ψ , Δ)为样品的椭偏参数。

椭偏参数定义式如下:

$$\rho = \tan \Psi \exp(\mathrm{i}\Delta) = \frac{r_{\mathrm{p}}}{r_{\mathrm{c}}}, \qquad (9)$$

式中 r_p为椭偏光 E 分量在入射平面内的反射系数, r_s为椭偏光 E 分量在与入射平面垂直的平面内的 反射系数。

根据 Fresnel 反射定律^[13],两种介质交界面反 射时的反射系数为

$$\begin{cases} r_{ab,p} = \frac{n_b \cos \theta_a - n_a \cos \theta_b}{n_b \cos \theta_a + n_a \cos \theta_b} \\ r_{ab,s} = \frac{n_a \cos \theta_a - n_b \cos \theta_b}{n_a \cos \theta_a + n_b \cos \theta_b}, \end{cases}$$
(10)

式中 a,b 分别指代上下两层介质; N = n - ik, n < k均为介质的光学参数;特殊地,光从空气入射到光介 质中,在单层薄膜表面反射时的反射系数 $r_p < r_s$ 为^[11]

$$r_{\rm p} = \frac{r_{01,\rm p} + r_{12,\rm p} \exp(-i2\beta)}{1 + r_{01,\rm p} r_{12,\rm p} \exp(-i2\beta)},$$

$$r_{\rm s} = \frac{r_{01,\rm s} + r_{12,\rm s} \exp(-i2\beta)}{1 + r_{01,\rm s} r_{12,\rm s} \exp(-i2\beta)},$$

$$\beta = 2\pi \frac{d}{\lambda} n_{\rm 1} \cos \theta_{\rm 1},$$
(11)

式中 0、1、2 分别代表空气、第一层薄膜、第二层薄膜; θ₁ 为从一层膜入射到二层膜的入射角。

需要强调的是,以上的表达式只在 C_s=0(即波 片旋转的起始位置为快轴或者慢轴)的前提下成立, 在实际的采集过程中,很难准确对应出 C_s=0 的位 置,所以必须知道 C_s不等于零时对应的表达式。通 过推导发现,两种傅里叶系数的对应关系^[10]为

 $\begin{bmatrix} \cos(mC_s) & -\sin(mC_s) \\ \sin(mC_s) & \cos(mC_s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha'_m \\ \beta'_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_m \\ \beta_m \end{bmatrix}, (12)$

式中 (α'_m , β'_m) 指代 C_s 不等于零时的傅里叶系数;(α_m , β_m)为 $C_s = 0$ 时的傅里叶系数,m = 2,4。因此,根据 (4)~(12)式可以将傅里叶系数当作待求参数的函 数,即

 $\alpha'_{2}(P,A,C_{s},\delta,\theta_{0},d), \quad \beta'_{2}(P,A,C_{s},\delta,\theta_{0},d),$

常见的 PSC_RA 椭偏系统,其测量的特点在于: 测量时起偏器和检偏器固定不动,通过旋转波片得 到周期性的光强信息,进而从光强信息中提取出样 品的椭偏参数。具体过程一般为:1)对光强做傅里 叶分析,提取出测量样品的光强傅里叶系数;2)通过 傅里叶系数与校准参数以及椭偏参数的关系,求解 出椭偏参数;3)通过拟合样品的椭偏参数,得到样品 的厚度和入射角。

3 样品校准法

3.1 原理简述

由于椭偏测量最终目的在于测量样品的厚度, 所以我们尝试将整个校准或者测量过程做整体的回 归,分别得到在校准和测量过程中需要得到的参数 值。具体如下。

在校准时,对于单一波长而言,从(13)式中可以 看出,可以将傅里叶系数当作拟合参数的函数,即 直接通过拟合傅里叶系数,得到待求参数值。在 (13)式中,若厚度也作为拟合量,则拟合参数的个数 为6个,而对于一个样品的测量只能得到4个方程。 方程个数小于参数个数,会出现多解的情况。同样 地,厚度作为固定值,仍然是方程个数大于参数个 数。所以需要多个样品参与该校准过程,即

 $\begin{aligned} &\alpha'_{2i}(P,A,C_{s},\delta,\theta_{0},d_{i}), \quad \beta'_{2i}(P,A,C_{s},\delta,\theta_{0},d_{i}), \\ &\alpha'_{4i}(P,A,C_{s},\delta,\theta_{0},d_{i}), \quad \beta'_{4i}(P,A,C_{s},\delta,\theta_{0},d_{i}), \end{aligned}$ (14)

式中 *i* 指样品个数。在厚度作为拟合参数时,每增加一个样品参与校准,就增加 4 个可用的方程,待拟 合参数增加一个;当样品数大于 2 时,方程数目就比 参数个数多,所以该校准方法至少需要两个样品参 与校准;而厚度是否作为拟合参数,可根据实际情况 决定。如果将厚度作为拟合参数时,拟合出的厚度 与参考厚度相差较多,则应该固定样品的厚度值,因 为此时厚度的不准确,必然影响到其他参数值的准 确性。而实际测量中发现,厚度固定为参考值能使 这种方法的准确性增强。所以对该方法而言,参考 厚度的准确性显得相当重要。通常获取参考厚度值 的方式有两种:1)商业标准样品,如经美国国家标准 技术研究所(NIST)认证过的标准样品;2)自己制造 的样品,然后采用其他精密的测量仪器加以测量。 在测量时,利用新样品测得的傅里叶系数,固定校准 中得到的(*P*,*A*,*C*_s,δ,θ_o),同样通过拟合此时的傅里 叶系数,最小二乘拟合出厚度值*d*和入射角θ_o即可, 而不再通过拟合椭偏参数得到(θ_o,*d*)。

校准时,定义多波长多样品的误差评价函数:

$$\chi^{2} = \sum_{i=1}^{M} \left\{ \sum_{j=1}^{N} \left[(\alpha_{2ij}^{\exp} - \alpha'_{2ij})^{2} + (\beta_{2ij}^{\exp} - \beta'_{2ij})^{2} + (\alpha_{4ii}^{\exp} - \alpha'_{4ii})^{2} + (\beta_{4ii}^{\exp} - \beta'_{4ii})^{2} \right] \right\},$$
(15)

 $(\alpha_{4ij}^{exp} - \alpha'_{4ij})^2 + (\beta_{4ij}^{exp} - \beta'_{4ij})^2]$, (15) 式中*i*指代不同的样品,*j*指代不同的波长; (α_{2ij}^{exp} , β_{2ij}^{exp} , α_{4ij}^{exp} , β_{4ij}^{exp})指实验采得的傅里叶系数; (α'_{2ij} , β'_{2ij} , α'_{4ij} , β'_{4ij})指算法最后一次迭代完成后得到的计算傅 里叶系数。*N*为波长的总数;*M*为样品的总数。采用 最小二乘法,使误差函数不断趋近于 0,此时两组傅 里叶系数不断逼近,最终返回此时对应的参数(*P*, *A*,*C*_s, δ , θ_0)的值。

从(14)式可以看出,根据测量样品反射光强展 开的傅里叶系数(α'_2 , β'_2 , α'_4 , β'_4)与校准参数(P,A, C_s , δ , θ_0)均有关,若通过椭偏仪对2个已知光学常 数和厚度(n,k,d)的参考样品进行测量,可得到两 组傅里叶系数,即8个方程,而未知参数仅为(P,A, C_s , δ , θ_0),即未知参数最多仅有5个,因此,此时可以 通过最小二乘法计算拟合出校准参数(P,A, C_s , δ , θ_0)。并且,为了使拟合得到的光学系统参数更加准 确,可以考虑让尽量多的样品参与校准。这是因为, 样品数量越多,即方程个数越多,对校准参数的限制 也就越多,此时通过最小二乘法得到的解也就越逼 近真实值。

3.2 模拟分析

3.2.1 方法的可行性验证

为了说明该方法的可行性和拟合出的参数的准确性,在单波长(此时 N=1),两个样品的情况下, 对该方法做了模拟。假定样品厚度为 100、200、 300、400、500 nm,任取两个参与校准。这些假定厚 度对应的椭偏参数如表 1 所示。

选取 He-Ne 激光器的输出波长 632.8 nm,将 样品厚度作为拟合参数,校准参数的人为设定值为 $(P,A,C_s,\delta,\theta_0) = (45^\circ, 30^\circ, -20^\circ, 90^\circ, 60^\circ)$ 。先利 用设定值计算出光强,分析出傅里叶系数,然后采用 该校准方法找回校准参数。模拟结果如表 2 所示。 表1 用于模拟分析样品的椭偏参数分布

	Table 1 Ellips	sometry paramet	ers of samples	used in sim	ulations					
Sample thinkness /nm	100	200		300	400	500				
$\Psi /(^{\circ})$	40.980	33.91	10 11	2.548	52.025	28.564				
Δ /(°)	79.744	279.02	23 19	9.194	82.621	274.335				
表 2 样品校准法对厚度测量的模拟结果										
Table 2 Result of thickness measurement with sample calibration										
Sample thinkness /nm	P/(°)	$A/(^{\circ})$ $C_{\rm s}/$	(\circ) $\theta_0/(\circ)$	δ / (°)	$d_1/$ nm	d_2 / nm				

Sample thinkness /nm	P/(°)	A/(°)	$C_{ m s}/(°)$	$ heta_0/(\degree)$	δ / (°)	$d_1/$ nm	d_2 / nm
100,200	45	30	-20	60	90	100/368.4	200/468.4
200,300	45	30	-20	60	90	200/468.4	300/568.4
300,400	45	30	-20	60	90	300/568.4	400/131.6
400,500	45	30	-20	60	90	400/131.6	500/231.6
500,100	45	30	-20	60	90	500/231.6	100/368.4

表 2 中 d₁ 和 d₂ 分别表示拟合出的两个参与校 准的样品厚度;从模拟结果来看,返回的参数值与设 定值完全一致。很明显的是,厚度出现了多解,经过 观察发现,出现多解的厚度周期为268.4 nm;即椭偏 参数每间隔 268.4 nm 出现了周期性的重复。这种现 象可以从(11)式中得到解释,即由于r_n和r_s中 exp(-i2β)项的存在,周期性变化的厚度会对应相同 的 $\exp(-i2\beta)$ 值, 进而造成 $\frac{r_0}{r}$ 对厚度的不可分辨。具 体来说,当 2β 为 2π 的整数倍时,即 $4\pi dn_1 \cos \theta_1/\lambda =$ $\frac{4\pi d \sqrt{n_1^2 - n_0^2 \sin^2 \theta_0}}{\sqrt{n_1^2 - n_0^2 \sin^2 \theta_0}} = 2\pi$ 时,将 $\lambda = 632.8 \text{ nm}, n_1 = 632.8 \text{ nm}$ 1.4567, $n_0 = 1$, $\theta_0 = 60°$ 代入, 求得的 d 即为厚度周 期值。这样计算得出其周期约为 270.12 nm。但是就 校准而言,只关心(P,A,C_s,δ,θ_o)是否得到真实值, 厚度的多解并不影响校准参数值的准确性。经过以 上模拟,证明了该方案的可行性。此外,值得一提的 是,虽然以上模拟是将厚度值作为了拟合参数,但不 难想象,如果将厚度值固定在设定值,通过该方法同 样可以得到其他参数的真实值。

3.2.2 误差函数对入射角的敏感性分析

为了观察该方法对入射角的敏感性以及这种敏 感性与参与校准的样品数量以及其椭偏参数分布之 间的关系,分别比较了采用2~6个样品参与校准, 所使用样品为 Si 衬底上的二氧化硅,由中国科学院 微电子研究所第十研究室制备。对应于 632.8 nm 波长, Horiba 椭偏仪提供的光学常数 n=1.45705, k=0。表3列出了实际所用样品的椭偏参数,样品 取法为从表 3 所列厚度从左向右依次增加一个。模 拟时将厚度固定为设定值,为了有效地和实验进行 比较,设定的厚度值为实际所用样品的厚度。当前, 对于薄膜量测设备制造商,通常采用一片美国 NIST 指定的 VLSI Standards, Inc. 制作的二氧化 硅样品作为标准样品。根据文中所述方法,应采用 相同的样品,但由于价格在每片 3000~5000 美金 (4 inch, 约 10.16 mm),成本无法承受,而且实验环 境也无法匹配标准样品的要求,从而选择了采用自 制品(薄片为干法热氧化,厚片为湿法氧化),并且引 用Horiba椭圆偏振仪测量结果作为标样的方法。 最终采用的厚度值为 Horiba 椭偏仪多次测量拟合出 的中心值,其重复精度优于 0.025 nm。误差函数对 其样品个数做归一化[(15)式]。将入射角 6。依次固 定在其真实值附近,拟合其余校准参数,观察误差函 数的变化。

表 3 现有样品的椭偏参数分布

Table 3 Ellipsometry parameters of current samples										
Sample thickness /nm	2.676	4.719	6.364	8.801	13.071	101.222	289.440			
$\Psi /(\degree)$	10.584	10.725	10.892	11.217	11.985	41.652	10.759			
Δ /(°)	171.749	166.015	161.518	155.115	144.796	79.820	165.023			

如图 2 所示,在 6 个样品时,误差函数曲线出现典型的二次曲线分布;而 2~5 个样品误差函数值很小, 且在 60°以后几乎重合,因此认为这种现象是由于样品 椭偏参数的分布不均匀造成。在 2~5 个样品时,现有

样品的 Ψ值大多在 10°左右,而 Δ 大多在 160°左右,各 样品之间椭偏参数的可分辨度不强。而有 6 个样品参 与校准时,因为包含了 101.222 nm 样品,其椭偏参数与 其余样品差异显著,所以误差函数变得陡峭。为了进 一步证实该解释,重新挑选了新厚度的样品,做相同的 模拟。由于从(11)式中知道其厚度周期为 270 nm 左 右,所以从 100~350 nm 范围内等间隔挑取了 6 个厚度 值,样品取法为从表 4 所列厚度从左向右依次增加一 个。其椭偏参数分布如表 4 所示。

使用这些厚度值参与校准,得到的误差函数与 入射角 θ。的关系如图 3 所示。与图 2 相比,图 3 的 误差函数的数值上升了一个数量级,即这种厚度组 合参与校准,入射角的不准确性更容易在误差函数 中突显出来。同时,5 条曲线都呈现出抛物线形状。 此外,可以看到,对样品个数归一化之后,此时采用 3 个样品校准的误差函数最陡峭,而 6 个样品校准 的误差函数位于最下方。另一方面,在误差函数小 到 10⁻⁴数量级时,5 条曲线所对应的入射角值最多 仅相差 0.05°;当误差函数值更小时,5 条曲线所对 应入射角值差异将更小。

综上所述,并非参与的样品越多,校准效果就越 好,还与样品的选择(椭偏参数是否分布均匀)密





切相关。值得注意的是,该项模拟没有考虑实验误 差的存在;在实际的校准过程中,还是希望有尽量多 的样品参与此校准过程,这样可以有效地消除偶然 误差。

表 4 100~350 nm 范围内厚度的椭偏参数分布

Table 4	Ellipsometry	parameters of	thicknesses	in the	range of	$100 \sim 350 \text{ nm}$
---------	--------------	---------------	-------------	--------	----------	---------------------------

Sample thickness / nm	100	150	200	250	300	350
$\Psi /(\degree)$	40.980	75.854	33.910	17.760	12.543	27.690
$\Delta/(\degree)$	79.744	265.457	279.023	249.445	139.194	86.748





Fig. 3 Sensitivity of error function to incident angle θ_0 for calibrating samples with the uniformly distributed ellipsometry parameters

3.3 样品校准法的实验结果分析

在模拟分析的基础上,将该校准方法应用在单 波长椭偏校准的实验之中。由于现阶段条件所限, 暂时只有如表3所示厚度的样品。采用输出波长为 632.8 nm的 He-Ne 激光器作为光源,使用中心波 长为 632.8 nm 的 1/4 波片作为补偿器,波片由电机 带动旋转,旋转角速度为 1800°/s,数据采集频率为 20 kHz,采用光电二极管作为探测器。采用 7 个样 品参与校准,厚度值由 Horiba 椭偏仪测得,如表 3 所示。

使用这些样品得到的校准测量值如表 5 所示。

由表 5 可知,大部分参数的标准偏差在 0.1°~ 0.2°,其中偏差最大的为入射角θ。,这与椭偏系统的 两臂稳定性有关。为了说明该校准方法得到的校准 参数是否合理,下一步固定住这些校准参数,反过来 测量样品的厚度值。

利用得到的校准参数(平均值),测量样品的厚度,其结果如表 6 所示。表中平均值和标准偏差 (SD)均表征 5 次测量的重复性,相对偏差为标准偏 差与平均值之比,最大误差为测量厚度与标准厚度 之间的最大偏差,相对精度为最大误差与标准厚度 之比。

如表 6 所示,随着样品厚度的增加,测量精度增 大,而相对偏差逐渐降低;除 2.676 nm 的样品外, 其余样品的最大误差在 0.25 nm 附近波动,同样相 对精度随着厚度的增加而逐渐降低。以上测量结果

Table 5 Calibrated parameters from 5 measurements using the sample calibration method [unit: (°)]										
Parameters	1	2	3	4	5	Mean	SD			
Р	131.95	132.23	132.33	132.15	132.06	132.14	0.15			
Α	-9.60	-9.93	-9.68	-9.62	-9.54	-9.67	0.15			
$C_{ m s}$	53.18	52.77	52.98	53.08	53.14	53.03	0.17			
δ	90.002	90.002	90.003	90.004	90.004	90.003	0.001			
$ heta_{ m o}$	68.48	68.26	67.82	68.19	68.18	68.19	0.23			

表5 样品校准法5次测量的校准参数值[单位:(°)]

表 6 利用校准参数测量样品得到的厚度值

Table 6 Measured thicknesses based on the calibrated parameters

Standard thickness / nm	Thickness 1 /nm	Thickness 2 /nm	Thickness 3 /nm	Thickness 4 /nm	Thickness 5 /nm	s Mean / nm	SD / nm	Relative deviation / %	Maximum error /nm	Relative precision / %
2.676	30.38	30.27	30.33	30.31	30.15	30.29	0.09	0.30	0.36	13.50
4.719	49.34	49.22	49.18	49.19	49.08	49.20	0.09	0.18	0.22	4.66
6.364	65.15	64.91	65.19	65.10	64.97	65.06	0.12	0.18	0.16	2.51
8.801	88.17	87.94	88.14	88.10	88.04	88.08	0.09	0.10	0.02	0.23
13.071	128.34	128.10	128.52	128.61	128.61	128.44	0.22	0.017	2.6	2.00
101.222	1011.35	1009.79	1009.73	1011.22	1011.31	1010.68	0.084	0.08	2.5	0.25
289.440	2895.62	2897.21	2897.01	2895.67	2895.65	2896.23	0.081	0.03	2.6	0.09

表明,在现阶段厚样品的厚度准确性比薄样品高。 造成该现象的原因:1)有可能是较薄样品在校准和 测量过程中敏感性不够,从而导致数据处理过程中, 对薄样品的厚度分辨力不够。2)薄样品自身的氧 化,使其本身的厚度变厚,与参考值相差较多。

4 结 论

首先阐述了样品校准法的基本思路和原理及其 与传统校准方法相比的优势所在。然后从数学上分 析了该方法的可行性,进而通过模拟的手段分析了 该方法对入射角 θ。的灵敏性。为了进一步说明该 方法的实用性,将该校准方法应用到了单波长激光 椭偏仪的校准中,利用校准结果测量了样品厚度值, 并与其参考值相比较。除 2.676 nm 样品(超薄样 品在测量时很容易受环境和其表面状态的影响)外, 数据表明,多次测量的最大标准偏差为 0.084 nm, 最大相对偏差为 0.18%;最大测量误差为 0.26 nm, 最差相对精度为 4.66%。从方法上来讲,证明了该 方法的可行性和可靠性。在着重阐述该新方法的基 础上,实验部分已经基本证明了方法的有效性;方法 的准确性还需要在将来的研究工作中进一步完善和 提高。此外,该方法的校准结果尚有提升的空间:1) 选取椭偏参数分布较为均匀的样品参与校准,正如 图 3 所示,可以有效地提高误差函数对拟合参数的 敏感性;下一步将定制椭偏参数分布均匀的样品做 更准确的分析。2)采用不同的归一化方式,在本文 中采用的是对(4)式中的直流分量 α₀ 归一化。3)选 择更加可靠的样品厚度参考值,无疑也是改善结果 的重要办法。4)比较光路中采用聚焦或者不聚焦方 式得到的测量效果等。

值得说明的是,目前该种新颖的椭偏样品校准 法已申请专利。

参考文献

1 Wu Suyong, Long Xingwu, Yang Kaiyong. Technique to minimize the characterization deviations of optical parameters of thin films caused by ellipsometric measurement systematic errors [J]. Acta Optica Sinica, 2012, 32(6): 0631001

吴素勇, 龙兴武, 杨开勇. 一种最小化薄膜光学参数表征偏差的 椭偏测量系统误差处理技术[J]. 光学学报, 2012, **32**(6): 0631001

- 2 Fan Longfeng, Lin Tianxia, Huang Zuohua. New algorithm to the ellipsometric data inversion of double films [J]. Laser Technology, 2012, 36(5): 589~592 范龙凤,林天夏,黄佐华. 双层膜椭偏数据处理的新算法[J]. 激 光技术, 2012, 36(5): 589~592
- 3 Li Xiaowei, Zhou Yi, Sun Lili. Determination of chemical bond of tetrahedral amorphous carbon films by an ellipsometry approach [J]. *Acta Optica Sinica*, 2012, **32**(10): 1031005 李晓伟,周 毅,孙丽丽. 椭偏法表征四面体非晶碳薄膜的化学 键结构[J]. 光学学报, 2012, **32**(10): 1031005

4 Liu Wende, Chen Chi, Zhang Hang. Effect of glass substrate and surface roughness on ellipsometric measurement of silicon nitride films [J]. Chinese J. Lasers, 2012, **39**(s1): s107002 刘文德,陈 赤,张 航. 玻璃基底和表面粗糙度在氮化硅薄膜 椭偏测量中的影响[J]. 中国激光, 2012, **39**(s1): s107002

5 Zhang Keqi, Yan Yixun. Method of improving accuracy of rotating analyzer ellipsometer [J]. Acta Optica Sinica, 1988, 8(3): 229~234 张克奇, 严义埙.提高旋转检偏器式椭偏仪准确度的方法[J]. 光学学报, 1988, 8(3): 229~234

- 6 Feng Xingwei, Su Yi, Ma Hongzhou *et al.*. New design of anglevariable spectroscopic ellipsometer (RPA type) [J]. *Acta Optica Sinica*, 1995, **15**(4): 492~498
- 冯星伟,苏 毅,马宏舟等.可变入射角波长扫描 RPA 型椭偏 仪的研制[J]. 光学学报,1995, **15**(4):492~498
- 7 Laurent Broch, Aotmane En Naciri, Luc Johann. Systematic errors for a Mueller matrix dual rotating compensator ellipsometer [J]. Opt. Express, 2008, 16(12): 8814~8823
- 8 R. M. A. Azzam, N. M. Bashara. Ellipsometry and Polarized Light [M]. Amsterdam: North Holland Publishing Co., 1988, 166
- 9 Ilsin An, Jaeho Lee. A single zone azimuth calibration for rotating compensator multichannel ellipsometry [J]. Jpn. J.

Appl. Phys., 2003, 42(5A): 2872~2875

- 10 Joungchel Lee, P. I. Rovira, Ilsin An *et al.*. Rotatingcompensator multichannel ellipsometry: applications for real time Stokes vector spectroscopy of thin film growth [J]. *Rev. Sci. Instrum.*, 1998, **69**(4): 1800~1810
- 11 Hiroyuki Fujiwara. Spectroscopic Ellipsometry Principles and Applications [M]. New York: John Wiley & Sons, Ltd. , 2007. $90\!\sim\!91$
- 12 R. Kleim, L. Kuntzler, A. El Ghemmaz. Systematic errors in rotating-compensator ellipsometry [J]. J. Opt. Soc. Am. A, 1994, 11(9): 2550~2559
- 13 Zhao Kaihua. New Concept Physics [M]. Beijing: Higher Education Press, 2004. 278~279
 赵凯华. 新概念物理教程[M]. 北京:高等教育出版社, 2004. 278~279

栏目编辑: 何卓铭